非隔离降压型 PFC 恒流 LED 驱动器

特点

- Buck PFC 恒流控制
- 准谐振软开关(谷底导通)
- 全电压微功耗设计
- 自动线电压补偿
- ±3%的 LED 输出恒流精度
- 极好的线性调整率和负载调整率
- 模拟及 PWM 调光
- THD 优化控制
- 线性过渡过压保护和温度保护
- 欠压保护、静电保护
- SOP8 小型封装
- 环境温度: -40~85℃

概述

R8031S 是一款专为非隔离降压型(Buck)恒流 LED 驱动设计的 PFC 控制器,芯片全程工作在准谐振软开关(谷底导通临界)模式,因此具有 PF 高、THD 低、效率高、EMI 低、电感利用率高且自适应电感量变化等特点。芯片采用微功耗设计,典型启动电流小于 100uA,典型工作电流 200uA,因此可快速启动和简化 VCC 供电电路。芯片采用了包括自动线电压补偿(无需线电压采样)技术在内的高精度恒流控制技术,在保证 PFC 控制的前提下,即使输入电压和输出电压大幅度变化仍然能保证极高的恒流精度。

除常规的欠压保护、静电保护外,芯片还采用了线性过渡的过压保护和温度保护,在过压或超温临界 点前,均会自动减少输出电流,直到零输出,由此大大提高了可靠性。

芯片内部集成了模拟调光及 PWM 调光专用电路,可接受远程的 PWM 信号或者电压信号进行调光,也可以就地简单使用一个可调电阻进行全范围无闪烁 LED 调光。

针对 Buck PFC 工频谷底死区的特性,芯片集成了 THD 电路,以优化 THD 特性。

芯片支持浮地工作方式,仅需极少的外围元件,无需辅助绕组,单电压情况下甚至无需辅助 VDD 供电即可稳定工作。

应用范围

LED 驱动电源。





典型应用一(有辅助线圈)

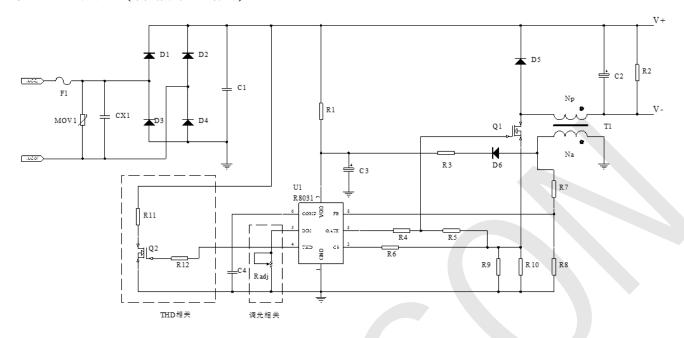


图 1 R8031S 典型应用线路一(有辅助线圈)

典型应用二(无辅助线圈)

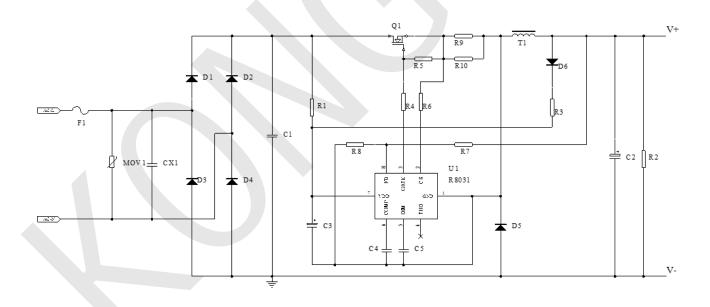


图 2 R8031S 典型应用线路二(无辅助线圈)



管脚排列

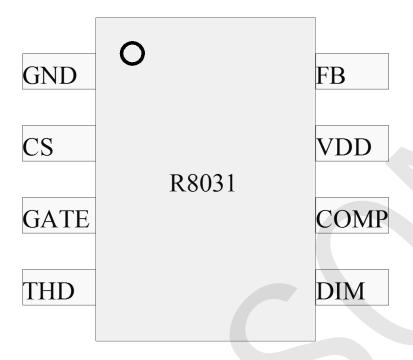


图 3 R8031S CF

管脚描述

管脚号	引脚名称	I/O	引脚功能描述		
1	GND	POWER	芯片地		
2	CS	I	电流检测脚,该引脚需连接一个适当的电阻到 MOS 管源极与采样电阻的		
			连接点,以获得对开关电流波形和线电压补偿的控制		
3	GATE	0	驱动脚,该引脚可通过一个适当的电阻或直接连接到 MOS 的栅极		
4	THD	0	THD 控制脚,该引脚可驱动另一个开关在谷底时适当导通以优化 THD		
5	DIM	I	调光脚,该引脚可直接接受 PWM 信号、电压信号或连接一个适当的电		
			阻到 GND 获得对输出电流的外部控制(调光)		
6	COMP	I	环路补偿脚,该引脚需要连接一个适当的电容到 GND 以获得必要的低带		
			宽 PFC 环路补偿参数的控制		
7	VDD	POWER	VDD		
8	FB	I	反馈信号输入脚,该引脚需要输入一个正确相位的电感端电压信号的分		
			压值,以获得对准谐振谷底以及过压保护阀值的控制		





电气参数(除非特别注明, TA=25℃)

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
供电							
内置稳压器电压	V_{DD}	VDD 灌入 1mA 电流	6.4	7.0	7.6	V	
VDD 最大灌入电流	I_{VDD}	VDD 灌入电流			10	mA	
最低 VDD 电压	V_{UVLO}	VDD 上升,Hys=0.5V	5.8	6.3	6.8	V	
启动电流	I_{ST}	VDD 灌入电流		85	120	uA	
电流检测							
CS 端阈值电压	V_{CS}	TA=-45°C~85°C	410	420	430	mV	
最小 on time	T _{ON} (min)	设计电感值不要低于最大值	500		800	nS	
调光							
最小调光电压	V _{DIM} (min)	低于此电压无法调光	0.4	0.5	0.6	V	
最大调光电压	V _{DIM} (max)	高于此电压输出最大电流	1.5	1.75	2.0	V	
反馈检测							
FB 端电压(恒压模	V_{FB}		1.3	1.35	1.4	V	
式)							
FB 端电压(输出	V_{FB}		1.45	1.5	1.55	V	
OVP 电压)							
过温保护							
热关断保护温度	T_{SD}			140		$^{\circ}$ C	
温度保护迟滞				20		$^{\circ}$ C	

极限参数

参数名称		符号	最大工作范围	单位
电源电压		V_{DD}	-0.3~8.0	V
输入端电压		V _I	-0.3~ V _{DD} +0.3	V
输出端电压		Vo	-0.3~ V _{DD} +0.3	V
功耗(在 25℃时)	CF (SOP8)	PD	630	mW
热阻(在 25℃时)	CF (SOP8)	Θ_{JA}	150	°C/W
ESD 保护(人体模	式)	ESD	2000	V
储存温度		T_{STG}	-55~150	$^{\circ}$
结温			150	$^{\circ}$
焊接温度(锡焊,	10秒)		300	$^{\circ}$

注:超出所列的极限参数可能导致器件的永久性损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下工作, 器件的技术指标将得不到保证,长期在这样的工作条件下还会影响可靠性。



内部框图

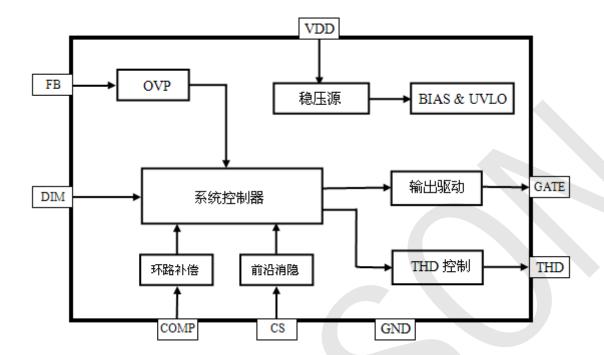


图 4 R8031S 内部框图





应用信息

R8031S是一款含主动PFC功能的非隔离降压型LED恒流控制芯片,芯片全程工作在准谐振软开关(谷底导通临界)模式,因此具有PF高、THD低、效率高、EMI低、电感利用率高且自适应电感量变化等特点。

启动电阻计算

R8031S 启动电流低,典型启动电流为 85uA, 计算启动电阻时一般选 100uA。当输入电压为 85Vac,

启动电阻(R1)计算公式如下: 启动电阻为 $\frac{85*\sqrt{2}}{100}=1.2M$ (典型值)。

芯片供电

R8031S可由辅助线圈供电或者直接由输出电压供电。

辅助线圈供电时,设计辅助线圈 (Na)和主线圈匝数 (Np),应遵循以下规则: $\frac{Np}{Na} = \frac{Vout}{9}$,例如输

出电压为90V,则
$$\frac{Np}{Na} = \frac{90}{9} = 10$$
;

由输出电压给芯片供电时,整流二极管D6应选用快恢复二极管。

两种供电方式都必须选择合适的限流电阻以保证芯片VDD电压稳定在7V(典型值),工作电流不低于1mA(功率越大所需工作电流越大)。

电流采样电阻

CS脚用来检测电感峰值电流。在一个交流周期内检测电感上的峰值电流,CS端连接芯片内部,并与内部420mV的电压基准进行比较,当CS达到内部阈值时,系统会关掉外部功率管。

峰值电流计算:

$$Ipk = \frac{420}{Rcs}(mA) \tag{1}$$

Rcs为电流采样检测电阻。

输出电流计算:

$$Iout = 0.45 * \frac{Ipk}{\sqrt{2}} (mA) \tag{2}$$

采样电阻计算:

$$Rcs = \frac{0.45 * 0.42}{\sqrt{2} * Iout} \tag{3}$$

电感设计

R8031S是采用谷底开关,*Ton* 固定的工作模式,系统上电后功率管导通,储能电感电流逐渐上升,当导通时间达到*Ton* 时,外部功率管关断。

Ton 可按下式计算:

$$Ton = \frac{L * Ipk}{Vin(\max) - Vout(\max)}$$
 (4)





L为储能电感的电感量, $Vin(\max)$ 是最高交流输入电压峰值, $Vout(\max)$ 是最高输出电压 ,Ipk 为峰值电流,由公式(1)得到:

当外部功率管关断后,储能电感电流开始逐渐下降,当下降到 0 时,外部功率管开启。 外部功率管的关断时间如下:

$$Toff = \frac{L * Ipk}{Vout(max)} \tag{5}$$

此时工作频率

$$f = \frac{1}{Ton + Toff} = \frac{(Vin(\max) - Vout(\max)) * Vout(\max)}{L * Vin(\max) * Ipk}$$
 (6)

电感的计算公式如下:

$$L = \frac{(Vin(\max) - Vout(\max)) * Vout(\max)}{f * Vin(\max) * Ipk}$$
(7)

设计 L 时,首先选定 f , f 应低于 100K,以避免功率管功耗太大。选定 f 后,根据公式(7)计算 出 L 。

计算出L后,应根据式(8)验证f,由公式(8)得到的f不得小于20-25K,以免进入音频范围内。

如小于,则应增大式(7)中f应的选值,重新设计L,并根据式(8)重新验证。

$$f = \frac{(Vin(\min) - Vout(\min)) * Vout(\min)}{L * Vin(\min) * Ipk}$$
(8)

Vin(min)为最低交流输入电压峰值, Vout(min)为最低输出电压。

FB 检测

FB 端的电压决定了系统的工作状态,当 FB 端电压低于 1.35V (典型值)时为正常工作状态,当 FB 上升到 1.35V(典型值)时,R8031S 会自动进入恒压模式,输出所接灯串越多,输出电流越小,当 FB 电压上升到 1.5V (典型值),R8031S 会自动判断为输出过压保护,系统会进入极为省电的打嗝模式。

1) 当采用辅助线圈供电的情况下,输出过压保护电压如下:

$$Voutovp = \frac{N_p}{Na} * \frac{R_8 + R_7}{R_8} * 1.5V$$
 (9)

其中 Np 为主线圈匝数, Na 为辅助线圈匝数;

2) 当由输出电压供电的情况下,输出过压保护电压如下:

$$Voutovp = \frac{R_8 + R_7}{R_8} * 1.5V$$
 (10)
无锡矽瑞微电子有限公司





选取 R7 应按以下公式计算:

当采用辅助线圈供电的情况下,有:

$$Vout(\max) = \frac{N_p}{Na} * \frac{R_8 + R_7}{R_8} * 1.35V$$
 (11)

当由输出电压供电的情况下,有:

$$Vout(\max) = \frac{R_8 + R_7}{R_{\circ}} * 1.35V$$
 (12)

其中Vout(max)为最大输出电压,R8通常取10K,式中常数1.35可取更小以免进入恒压范围。

R8031S 在进入打嗝模式后,自动检测输出电压,当输出电压低于 Vout(max)时,系统会重新进入正常工作状态。

开路保护

R8031S内部集成了开路保护功能,R8031S一旦检测到输出开路,系统会自动进入打嗝模式,开路状态移除后会重新进入正常工作状态。

调光

调光有两种方式:线形调光、PWM调光。

线形调光:通过在 DIM 脚加 0.5 到 1.75V 电压而实现,当该端所加电压高于 1.75V 时将不影响输出电流。

PWM 调光: 通过在 DIM 脚一个几百 Hz 的 PWM 信号就可以实现。PWM 信号的占空比正比于输出电流。

上述调光功能只能在双线圈应用的情况下实现。

THD 优化

R8031S 为非隔离降压型主动 PFC 芯片,提供了外部 THD 调节功能。

如图 1 所示,图中 R11、R12 和 Q2 组成 THD 优化电路,此电路可显著降低电路的 THD,提高 PF 值。 上述 THD 优化功能只能在双线圈应用的情况下实现。

过温保护

R8031S 内部集成了过热保护功能,触发过热保护温度为典型 140° C,当 R8031S 被触发过热保护后,芯片只有降到 120° C之后,才能重新正常工作。

PCB 设计

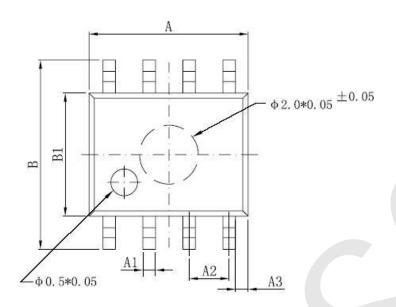
- 1、充电回路及放电回路环路面积尽量小;
- 2、芯片滤波电容尽量靠近芯片GND;
- 3、功率回路与信号回路分开;
- 4、FB脚接地端电阻要靠近VDD滤波电容地端;
- 5、若不需调光,则推荐DIM脚对地接一小的瓷片电容(C5)以避免干扰。

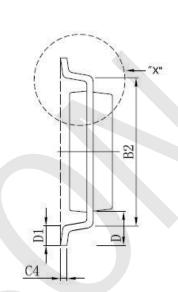


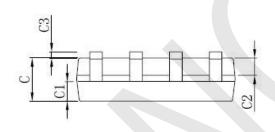


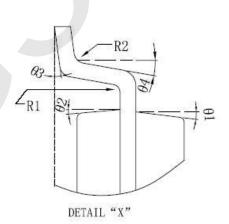
封装尺寸

SOP8 封装外形图及尺寸









标注	最 小 (mm)	最大(mm)	尺寸 标注 一	最 小 (mm)	最 大 (mm)
Α	4,95	5,15	C3	0.05	0,20
A1	0,37	0,47	C4	0.20TYP	
A2	1.27TYP		D	1,05TYP	
A3	0.41TYP		D1	0.40	0.60
В	5,80	6,20	R1	0.07TYP	
B1	3,80	4.00	R2	0.07TYP	
B2	5.0TYP		θ1	17° TYP	
С	1,30	1,50	θ2	13° TYP	
C1	0.55	0,65	θ3	0° ~8°	
C2	0.55	0.65	θ4	12° TYP	